

СОДЕРЖАНИЕ

Том 49, номер 6, 2020

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

Кинетика и механизмы реактивно-ионного травления Si и SiO₂
в плазме смеси HBr + O₂

А. М. Ефремов, В. Б. Бетелин, К.-Н. Kwon 403

Технология наноразмерных слоев металлов для формирования надежного
контакта к стоковой области кремниевых транзисторов

Т. А. Исмаилов, А. Р. Шахмаева, Б. А. Шангереева 409

Термическое атомно-слоевое осаждение TiN_x с использованием TiCl₄ и N₂H₄

А. И. Абдулагатов, М. Х. Рабаданов, И. М. Абдулагатов 413

ПРИБОРЫ

СВЧ характеристики усилителей на наногетероструктурах нитрида галлия
в диапазоне частот 80–100 ГГц

*Д. Л. Гнатюк, Р. Р. Галиев, А. В. Зуев, С. Л. Крапухина, М. В. Майтама,
П. П. Мальцев, О. С. Матвеевко, Ю. В. Федоров* 429

Инжекционный диффузионно-дрейфовый формирователь импульсов

Д. С. Гаев, С. Ш. Рехвиашвили 436

МАТЕРИАЛЫ

Аморфизация оксидов ванадия при обратимом внедрении лития

*А. М. Скундин, А. А. Мироненко, А. С. Рудый, И. С. Федоров, С. В. Васильев,
Л. А. Мазалецкий, Ю. С. Торцева, О. Е. Кузнецов* 442

Влияние точечных дефектов на скорость электромиграции
по границе соединенных материалов

Т. М. Махвиладзе, М. Е. Сарычев 450

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Концепция пятен для задач искусственного интеллекта
и алгоритмов нейроморфных систем

Н. А. Симонов 459

Моделирование нормально закрытого НЕМТ транзистора
на основе GaN/AlGaIn с *p*-затвором

В. И. Егоркин, В. Е. Земляков, В. В. Капаев, О. Б. Кухтяева 474
